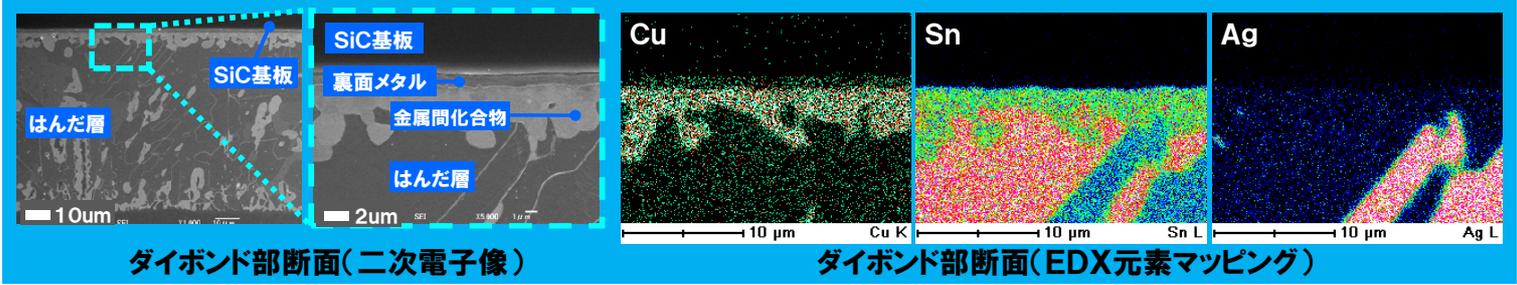
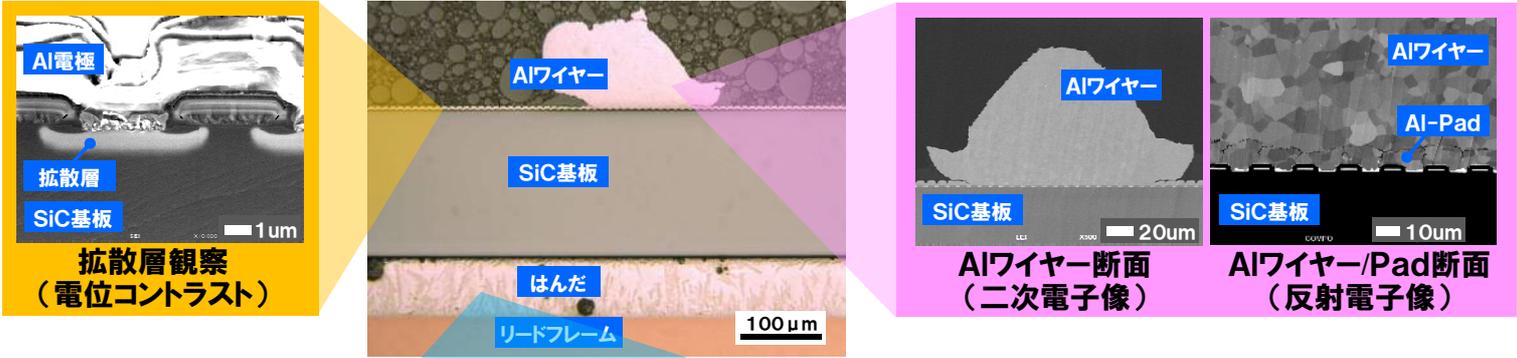


SiCデバイスの解析技術

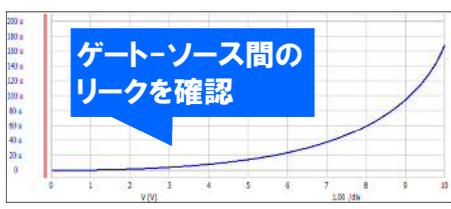
構造解析から故障解析まで幅広いニーズにお応えします！

パッケージ構造の断面解析(FE-SEM観察→EDX分析)



様々な断面観察, 分析手法を用いてSiCデバイスの構造を明らかにする事が可能

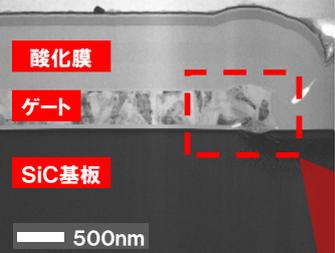
SiCデバイスの故障解析



①電気特性試験



③故障位置特定(OBIRCH)



④物理解析(STEM)



裏面OBIRCH測定 (模式図)

EMS/OBIRCHで特定された故障位置の物理解析を行い, 故障の状況を明らかにすることが可能